

Germanium-Universaldioden

Typ	max. Sperrspannung	max. Durchlaßstrom	max. Sperrstrom bei		Durchlaßstrom I_F	Zusätze	Bauform
	U_R (V)	I_F (mA)	$U_R = 10\text{ V}$ (μA)	$U_{R\text{max}}$ (μA)	bei $U_F \leq 1\text{ V}$ (mA)		
GA 100	20	20	100	500	5	*)	1
GA 101	40	15	40	400	3	*)	1
GA 102	60	12	40	350	3	*)	1
GA 103	80	10	15	250	3	*)	1
GA 104	110	10	15	200	3	*)	1
GA 105	20	20	100	500	3	1)	1
2 GA 109	40	15	40	300	5	2) *)	1
2 GA 113	25	15	40	—	6	3)	1
4 GA 114	25	15	40	150	6 . . . 15	4)	1
0 4 A 657	40	15	40	300	7,5 . . . 12,8	5) *)	2

*) nicht für Neuentwicklungen

- 1) Richtspannungswirkungsgrad $\geq 0,65$ ($f = 39\text{ MHz}$)
- 2) Diodenpaar. Richtstrom bei $f = 10,7\text{ MHz} \geq 100\ \mu\text{A}$
Richtstromdifferenz zwischen beiden Einzeldioden $\leq 10\ \mu\text{A}$
- 3) Diodenpaar. Richtstrom bei $f = 10,7\text{ MHz} \geq 150\ \mu\text{A}$
Richtstromdifferenz $\leq 10\ \mu\text{A}$, Durchlaßstromdifferenz $\leq 1\text{ mA}$
(bei $U_F = 1\text{ V}$) zwischen beiden Einzeldioden Diodenquartett
- 4) Dynamische Kennwerte (bei $\vartheta_a = 25\text{ °C}$)

Sperrverzögerung

Sperrstrom nach $0,5\ \mu\text{s}$ $I_R \leq 500\ \mu\text{A}$

Sperrstrom nach $3,0\ \mu\text{s}$ $I_R \leq 80\ \mu\text{A}$

(Dabei wird die Diode durch symmetrische Rechteckimpulse mit einer Folgefrequenz von 50 kHz und einer Anstiegszeit von max. $0,1\ \mu\text{s}$ von $I_{RMM} = 30\text{ mA}$ auf $U_{RMM} = 10\text{ V}$ umgeschaltet)

Trägerdämpfung $\alpha_T \geq 5\text{ Np}$

(bei $f = 200\text{ kHz}$ und Eingangspegel 1 Np)

- 5) Diodenquartett

Trägerdämpfung $\alpha_T \geq 4,5\text{ Np}$ ($f = 6\text{ kHz}$, Eingangspegel 0)

Bauform 2